

Hírközlés Fejlesztési Központ létrehozása

Az ITU Adminisztratív Tanácsának azt a döntését követően, hogy létre kell hozni a Hírközlés Fejlesztési Központot (Centre for Telecommunication Development) a Nemzetközi Távközlési Unió keretében Genfben — a Központ Tanácsadó Bizottsága megtartotta első (alakuló) ülését az ITU Főhadiszállásán 1985. november 21—23 között.

A Bizottság elnökéül választotta Jean Claude Delorme urat a Teleglobe Canada elnökét és vezérigazgatóját, alelnökké A. D. Ntagazwa urat a Tanzániai Hírközlési, és Munkaügyi miniszter helyettesét.

Meghívott előadóként részt vett John Malecela úr a Világ Hírközlésfejlesztési Konferencia elnöke.

A Bizottság, amely a Központ átfogó irányítását fogja végezni 21 tagból áll, beleértve az ITU főtitkárát, mint első alelnököt (hivatalból) és a további 20 tagot, akik különböző régiókból és érdekeltségi körökből — adományozók és kedvezményezettek — származnak.

A Központ létrehozásának gondolatát a Világméretű Hírközlés Fejlesztési Független Bizottság („Missing Link”) vetette fel és ezt támogatta a Tanzániai Arushában 1985. májusában tartott Világ Hírközlési Konferencia. A Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy véleménye szerint „a segítségnyújtás területeit (a fejlődő országoknak) ki kell bővíteni és az ezt biztosító gépezetet ésszerűsíteni kell, ha el akarják érni a szükséges mértékű színvonal emelkedését”. A továbbiakban a Bizottság azt állította „hogy ez a segítség hatásossá váljon, az ezt biztosító rendszert felül kell vizsgálni és meg kell erősíteni”.

Az ITU Adminisztratív Tanácsa 1985. júliusában 40. Ülésén támogatta a Bizottság Jelentésének következtetéseibe és ajánlásaiba vetett általános bizalmat és ebből eredően úgy határozott, hogy létrehozza a Központot.

A Tanácsadó Bizottság ülése, amely lényegében alakuló ülés volt, szándékait a főbb általános politikai kérdésekre koncentráta, amelyek a Központ tevékenységének jog- és hatáskörére, a Bizottság szabályainak és munkamódszereinek megfogalmazására, a források mobilizálására és a Központ ügyvezető igazgatójának és igazgatóhelyettesének betöltésére vonatkoznak. Az utóbbi két állás betöltésére az ITU pályázatot írt ki.

Egy nap a szoba jöhető forrás-felajánlókkal

A november 22-i ülés — amely nyilvános ülés volt a szoba jöhető forrás felajánlók részére — nagy érdeklődést keltett. Ez az ülés lehetőséget nyújtott a Bizottságnak, hogy elmagyarázza azokat az előnyöket, amelyekre a Központ működéséből számíthatnak mind az adományozók, mind a haszonélvezők. Ugyancsak lehetővé tette a Bizottságnak, hogy értékelje a lehetséges hozzájárulásokat, amelyeket akár készpénzben, akár természetben kínáltak fel.

Az ülés során számos határozott elkötelezettséget jelentettek be a készpénzbeni és természetbeni hozzájárulásra.

Egyik ilyen nyilatkozó Nyiredy László a BUDAVOX

vezérigazgatója volt, aki a következőket mondta többek között:

„A magyar professzionális híradástechnikai ipar nevében van szerencsém bejelenteni, hogy a BUDAVOX Részvénytársaság kész résztvenni a Hírközlés Fejlesztési Központ finanszírozásában évi 50 000 USD összeggel azon feltétellel természetesen, hogy a Központ költségvetését teljes egészében fedezik a hozzájárulások és a Központ megkezdí működését.

Meg vagyok győződve, hogy ha a postai adminisztrációk és az iparvállalatok együttműködnek a „hiányzó láncszem” meghatározásában és létrehozásában, — idézem az arushai deklarációt — lehetővé téve „minden embernek, hogy a jövő század elejére könnyen hozzáférhessen a telefonhoz” ez modern civilizációnk egyik legnemesebb tette lesz.

Remélem, hogy az ehhez szükséges technológiai kooperáció hozzá fog járulni azon diszkriminációs akadályok körének feltöréséhez, amely a technológia átadás útjában áll, mert úgy gondolom, hogy a technológiai diszkrimináció egyike modern civilizációnk legelítélendőbb tevékenységeinek.

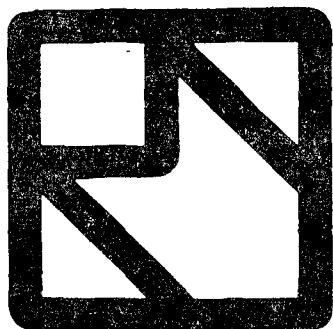
Mindenesetre azt hiszem a munkát egy vagy néhány konkrét rurál program megvalósításával kellene kezdeni és bejelentem, hogy a magunk részéről érdekelve vagyunk ilyen tanulmányok és konkrét programok megvalósításában való részvételben, akár rurál hálózatok építéséről legyen szó, akár az érdekelt országok számára történő technológia átadásáról ezen a területen. Készek vagyunk ezen Központ keretében együttműködni más ipari csoportokkal, postai adminisztrációkkal, hogy integrálni tudjuk tapasztalatainkat és a rendelkezésünkre álló erőket.”

Fentiek mellett néhány főbb jövőbeni adományozó, mint a Bizottság tagja kifejezte meglegedését azokkal a lépésekkel kapcsolatban, amelyek eddig történtek a Központ létrehozásának érdekében. Elégedettségüket nyilvánították a Bizottság ülésének menetével és a Központ hatás- és jogkörének tárgyalása során kialakult véleménycserével kapcsolatban.

Egyik hozzászóló egy közös nemzeti összefogásra hivatkozott, melyben résztvesz a kormány, az ipar és az üzemeltető társaságok — azt mondta, hogy országa „... egész biztosan megfelelő hozzájárulást fog tenni...”, míg egy másik kijelentette, hogy országának „... szándékában áll jelentős mértékű hozzájárulás, mind készpénzben, mind természetben” amint a „... végső vezérfonal kialakul”.

Az Elnök felidézte a Hírközlés Fejlesztési Központ fontosságát és azt mondta, hogy „A Központ már nem csupán egy koncepció, hanem valósággá vált...”. Speciális köszönetét fejezte ki azoknak, akik bejelentették „döntésüket vagy szándékukat” a Központ támogatására. Ugyancsak biztosította a résztvevőket, hogy a Tanácsadó Bizottság hasonló üléseket fog szervezni, azért, hogy „... felmérje a helyzetet mivel az adományozók, felhasználók és a nemzetközi hírközlési társadalom nagymértékű részvétele különös fontosságú volt”.

Horváth Imre

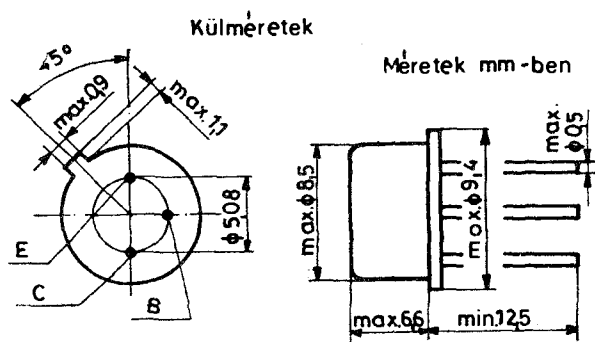


M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT

IV., Fóti út 56.

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306

Nagyfeszültségű szilícium PNP planár tranzisztor 2N 5415 2N 5416



Tok: TO-39
Tömeg: kb 1,5g

A kollektor a fémházzal
össze von kötve.

Ajánlott alkalmazás

A 2N 5415, 2N 5416 nagyfeszültségű szilícium epitaxiális planár PNP tranzisztor közszükségleti és ipari felhasználásra szolgál. Elsősorban meghajtóként alkalmazható nagyfeszültségű kis áramú inverterekben, kapcsoló és soros üzemi stabilizátorokban.

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető Ágazat Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendelkezésére (Telefon: 692-800/2337).

Schronk László

MAXIMÁLIS HATÁRADATOK	JELÖLÉS	2N 5415	2N 5416	EGYSÉG
Kollektor-bázis feszültség	$-V_{CB0}$	200	350	V
Kollektor-emitter feszültség	$-V_{CE0}$	200	300	V
Emitter-bázis feszültség	$-V_{EB0}$	4	6	V
Kollektor egyenáram	$-I_C$	1	1	A
Bázis egyenáram	$-I_B$	0,5	0,5	A
TELJES TELJESÍTMÉNYDISSIPÁCIÓ				
$T_{amb} 50^\circ C$	P_{tot}	1	1	W
$T_{case} 25^\circ C$	P_{tot}	10	10	W
Átmeneti hőmérséklet	T_j	150	150	$^\circ C$
Tárolási hőmérséklet	T_s	- 55... + 150		$^\circ C$
HŐELLENÁLLÁS				
átmenet és tok között	R_{thjc}	17,5	17,5	K/W
átmenet és környezet között	R_{thja}	150	150	K/W

STATIKUS JELLEMZŐK $T_{case} = 25^\circ C$ ha másként nincs meghatározva	JELÖLÉS	2N 5415	2N 5416	EGYSÉG
Kollektor-bázis visszáram ($I_E = 0$) $-V_{CB} = 175V$ $-V_{CB} = 280V$	$-I_{CBO}$ $-I_{CBO}$	≤ 50	≤ 50	μA μA
Kollektor-emitter visszáram ($I_B = 0$) $-V_{CE} = 150V$	$-I_{CEO}$	≤ 50	≤ 50	μA
Emitter-bázis visszáram ($I_C = 0$) $-V_{EB} = 4V$ $-V_{EB} = 6V$	$-I_{EBO}$ $-I_{EBO}$	≤ 20	≤ 20	μA μA
Tartós kollektor-emitter feszültség* ($I_B = 0$) $-I_C = 10mA$	$-V_{CEO(sus)}$	≥ 200	≥ 300	V
Tartós kollektor-emitter feszültség* ($R_{BE} = 50\Omega$) $-I_C = 50mA$	$-V_{CER}$		≥ 350	V
Kollektor-emitter maradék feszültség* $-I_C = 50mA$, $I_B = 5mA$	$-V_{CE sat}$	$\leq 2,5$	$\leq 2,5$	V
Bázis-emitter feszültség* $-I_C = 50mA$, $V_{CE} = 10V$	$-V_{BE}$	$\leq 1,5$	$\leq 1,5$	V
Egyenáramú áramerősítési tényező* $-I_C = 20mA$, $V_{CE} = 10V$	h_{21E} h_{21E}	≥ 30 ≤ 150	≥ 30 ≤ 120	

* Impulzus üzem: impulzus hossza = $300\mu s$ kitöltési tényező $\leq 2\%$

DINAMIKUS JELLEMZŐK $T_{case} = 25^\circ C$	JELÖLÉS	2N 5415	2N 5416	EGYSÉG
Kisjelű áramerősítési tényező $-I_C = 5mA$, $-V_{CE} = 10V$, $f = 1kHz$	h_{21e}	> 25	> 25	
Kollektor-bázis kapacitás $-V_{CB} = 10V$, $f = 1MHz$	C_{BO}	< 25	< 25	pF
Tranzitfrekvencia $-I_C = 10mA$, $-V_{CE} = 10V$, $f = 5MHz$	f_T	> 15	> 15	MHz



M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT